

InGaAs PIN фотодиоды ДФД2000ТО

Особенности

- Высокая чувствительность на 1.3 мкм и 1.55 мкм
- Спектральный диапазон 0.95-1.7 мкм
- Низкий темновой ток
- Активный диаметр приемной площадки 2000 мкм
- Конструкция с вводом излучения через мезаструктуру
- Корпус типа ТО-5

Области применения

- Тестовое оборудование для ВОЛС
- Термометрия
- Дальнометрия
- Спектроскопия

Краткое описание

PIN InGaAs/InP фотодиоды типа ДФД2000ТО созданы для прямого преобразования оптических сигналов в электрические в ближнем инфракрасном диапазоне. Модель ДФД2000ТО разработана для использования в качестве датчиков приема ИК оптического сигнала и имеют конструкцию с вводом излучения через мезаструктуру с большим активным размером 2000 мкм. Имеются два типа исполнения: кристалл на ситалловой подложке и корпус типа ТО-5 со стеклянным окном.



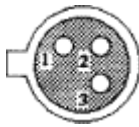
Технические характеристики ($V_r = -5V$, $25^\circ C$)

Модель	Фоточувств. площ., мкм	Спектральная чувствительность, А/Вт				Темновой ток, нА		Ёмкость, пФ		Время откл., нс тип	Корпус. исполн.
		1300нм		1500нм		тип	макс	тип	макс		
		мин	тип	мин	тип						
Корпус типа ТО-5 со стеклянным окном											
ДФД2000ТО	2000	0.65	0.75	0.75	0.85	120	200	270	350	30	С

Предельно допустимые значения

Напряжение обратного смещения	10 В
Обратный фототок	3 мА
Прямой ток	5 мА
Рабочая температура	-60...+55°C

■ **Обозначение выводов**



1. Анод ("-" пит)
2. Катод ("+" пит)
3. Корпус

НПФ «Дилаз»
Россия, Москва
тел (495) 104-05-51
факс (495) 333-05-13
e-mail: dilas@mail.magelan.ru